

Tarifas de Procesos por encomienda actualizadas a Marzo 2024

Etapa	Description	Area	Wafers	Cost /run (€)	Cost /wafer (€)	Cost /batch (€)	Wafer/batch
AAFM-ING	Caracterització per AFM	Nanolithography	4	1,16	13,5	0	4
AEFL-ING	Litografia per EBL a l'equip RAITH150TWO	Nanolithography	4	1,16	20,5	0	4
AFIB-ING	Nanoestructuració al FIB (talls, seccions, lamel·les, edició circuits...)	Nanolithography	4	1,16	34,8	0	4
AIXT-FE	Proceso de depósito CVD/PECVD de nanomateriales de Carbono con catalizador Fe	Thermal Process	1	30,38	0	0	1
AIXT-ING	Proceso de depósito CVD/PECVD de nanomateriales de Carbono	Thermal Process	1	30,38	0	0	1
AIXT-PT	Proceso de depósito CVD/PECVD de nanomateriales de Carbono con catalizador PT	Thermal Process	1	30,38	0	0	1
ALDD-ALM	Atomic layer deposition of dielectrics - Standard deposition of aluminum oxide	Thermal Process	10	2,93	10,97	0	10
ALDD-HAF	Atomic layer deposition of dielectrics - Standard deposition of hafnium oxide	Thermal Process	10	2,93	10,46	0	10
ALDD-ING	Dipòsit de capes dielèctriques per Atomic Layer Deposition (ALD)	Thermal Process	10	2,93	16,93	0	10
AMRIEING	Gravat RIE no estàndar a l'AMI-ETCH	Dry Etching	4	47,45	0,65	0,25	4
ANIL-ING	Nano-impressió amb el NIL d'Obducat de 4	Nanolithography	4	1,16	11,7	0	4
ASEM-ING	Inspecció SEM a l'equip LEO1530	Nanolithography	4	1,16	11,8	0	4
CMOS-MNC	Transferència de les mostres a porta-mostres MNC	Standard Production	25	0	0	0,85	25
DAMI-ING	Dipòsit de dielèctrics no estàndar per PECVD a l'AMIDEP	Thermal Process	8	22,61	6,59	0	8
DAMINTXX	Depósito de nitruro PECVD basado en silano	Thermal Process	8	22,61	2,01	0	8
DAMIOX11	Depósito de óxido PECVD TEOS1:1	Thermal Process	8	22,61	4,56	0	8
DAMIOX21	Deposición de óxido PECVD TEOS ratio 2:1	Thermal Process	8	22,61	4,57	0	8
DAMIOXC1	Deposición de óxido con silano PECVD	Thermal Process	8	22,61	1,87	0	8
DAMIPASX	Depósito PECVD de óxido TEOS y nitruro para pasivación	Thermal Process	8	22,61	3,89	0	8
DBPTEOSX	Deposición de óxido dopado PECVD TEOS de grosores variables	Thermal Process	8	22,61	5,59	0	8
DEC-ESP	Decapado especial de resina	Wet Etching	25	0,32	0	0	25
DEC-MNC	Decapado de resina en Tepla MNC	Wet Etching	0	0,16	0	0	0
DEC-RESI	Decapado de resina	Wet Etching	12	0,16	0	0	12
DESP-MNC	Decapado especial de resina en Tepla MNC	Wet Etching	12	0,32	0	0	12
DNIT-ING	Depósito no estándar de nitruro de silicio LPCVD	Thermal Process	24	29,87	0	0	24
DNITAAA	DEP. ESTANDAR DE 1800Å Si3N4	Thermal Process	24	23,53	0	0	24
DNITAAAB	DEP. ESTANDAR DE 1175Å Si3N4	Thermal Process	24	21,62	0	0	24
DNITXXX	DEP. SEMIESTANDAR DE Si3N4	Thermal Process	24	27,48	0	0	24
DNTPLOXF	Depósito de nitruro de silicio PECVD en obleas contaminadas	Thermal Process	7	11,15	0	1,8	7
DOXF-ING	Depósito PECVD de Ingeniería en obleas contaminadas	Thermal Process	7	11,15	0	4,95	7
DOXPLOXF	Depósito de óxido de silicio PECVD en obleas contaminadas	Thermal Process	7	11,15	0	2,59	7
DPAR-ING	Parylene thin film coating	Ionic Implantation	13	3,35	0	3,81	13
DPASXOXF	Depósito de óxido y nitruro de Si PECVD en obleas contaminadas	Thermal Process	7	11,15	0	4,95	7
DPOL-ING	Depósito no estándar de Polisilicio por LPCVD	Thermal Process	24	43,28	0	0	24
DPOLAAA	DEPOSICION DE 4800Å DE POLY	Thermal Process	24	41,14	0	0	24
DPOLAAB	DEPOSICION DE 3500Å DE POLY	Thermal Process	24	37,56	0	0	24
DPOLXXX	DEPOSICION SEMIESTAND. DE POLY	Thermal Process	24	33,44	0	0	24
DSIPLIOXF	Depósito de silicio amorfo PECVD en obleas contaminadas	Thermal Process	7	11,15	0	1,59	7
ENBBON	Conexionado eléctrico por BallBonding (Hilo de Au)	Packaging	1	1,5	0,72	0	1
ENCEXPWA	Expandir el plástico de la oblea cortada.	Packaging	1	0	0	0	1
ENCTAPEM	Preparación del aro con el plástico adhesivo y pegado de la oblea	Packaging	1	0	1,2	0	1
ENCURATE	Curado de epoxy por temperatura ambiente o superior.	Packaging	1	0	0	0	1
ENCURAUUV	Curado de epoxy por luz UV.	Packaging	1	0	0	0	1
ENDICESI	Corte de obleas de Silicio	Packaging	1	2,53	13,32	0	1
ENDIEATT	Pegado de chips en las bases.	Packaging	1	1,5	0,51	0	1
ENLOBTO	Protección hilos Bonding con epoxy.	Packaging	1	0	0	0	1
ENHWBOND	Conexionado eléctrico con hilo grueso de Al	Packaging	1	1,5	0,04	0	1
ENLAWAWA	Lavado de obleas, después del corte, de forma semiautomática en equipo específico.	Packaging	1	0	0	0	1
ENLAWAWM	Lavado de obleas, después del corte, de forma manual.	Packaging	1	0	0	0	1
ENSECADO	Secado a temperatura ambiente ó a 90°C de las obleas, después del lavado.	Packaging	1	0	0	0	1
ENTAPA	Protección hilos Bonding con tapa sobre base de encapsulado.	Packaging	1	0	0	0	1
ENUVTAPE	Aplicación de UV a las obleas para retirar el plástico adhesivo con facilidad.	Packaging	1	0	0	0	1
ENWBOND	Conexionado eléctrico con hilo fino de Al o Au, por wedge bonding.	Packaging	1	1,5	0,72	0	1
ESPECIAL	Proceso o etapa no estándar (por SB)	Standard Production	24	0	0	0	24
FEIN-ESP	Proceso o etapa no estándar fuera de la Sala Blanca	Standard Production	4	0	0	0	4
FESP-SIC	FOTOLITOGRAFIA DE OBLEAS DE SIC	Photolithography	10	0,22	5,7	0	10
FESPECIA	Fotolitografía especial sense seqüència d'aliniament predefinida	Photolithography	8	0,22	5,7	0	8
FIN-OBL	OBLEAS TERMINADAS	Standard Production	25	0	8,22	0,65	25
FIN-RECU	Final de un proceso de recuperación	Standard Production	25	0	0	0	25
FINAL	FINAL DEL RUN EN SB	Standard Production	25	0	8,22	0,65	25
FOTO-ALH	Fotolitografía sobre capas de aluminio con resina estándar, para grabado húmedo	Photolithography	8	0,22	5,71	0	8
FOTO-DLW	Proceso de litografía láser definido con el usuario	Photolithography	4	0,22	25,14	0	4
FOTO-ESP	Fotolitografía no estandar con proceso predefinido por usuario	Photolithography	4	0,22	5,7	0	4
FOTO-FCD	Fotolitografía estándar en obleas a doble cara sin protección de dorso	Photolithography	4	10,18	5,71	0	4
FOTO-FKD	Fotolitografía con alineamiento entre caras, SIN protección de cara opuesta	Photolithography	4	10,18	5,71	0	4
FOTO-FKR	Fotolitografía con alineamiento entre caras, con protección de cara opuesta	Photolithography	8	10,18	7,79	0	8
FOTO-FRD	Fotolitografía a 1 cara para obleas pulidas por ambas caras, con protección de c	Photolithography	4	10,18	7,79	0	4
FOTO-I12	Fotolitografía estándar a l'stepper Nikon i12D	Photolithography	25	17,82	5,39	0	25
FOTO-ING	Fotolitografía en condiciones no estándar acordadas con ingeniería	Photolithography	4	0,22	61,32	0	4
FOTO-MNC	Fotolitografía MNC, 1 ó 2 cares.Replicació dels procés CMOS.	Photolithography	4	10,18	5,23	0	4
FOTO-SAR	Fotolitografía sobre aluminio, con resina antireflectante. Apta para grabado sec	Photolithography	4	0,22	6,23	0	4
FOTO-STA	Fotolitografía con stepper para grabado seco de Al	Photolithography	4	17,82	5,91	0	4
FOTO-STN	Fotolitografía estándar con stepper (Proyección)	Photolithography	4	17,82	5,39	0	4
FOTO-STU	Fotolitografía estándar, alineamiento a 1 cara	Photolithography	4	0,22	5,71	0	4
GGIR-ESP	GRAVAT SEC NO ESTANDAR EN EL GIR 160.	Dry Etching	0	34,15	0,59	0	0
GGIR-ING	GRABADO SECO INGENIERIA EN GIR 160	Dry Etching	0	34,15	0,59	0	0
GHUM-ESP	Grabado húmedo especial	Wet Etching	24	19,25	0	18,92	24
GHUM-ING	Grabado húmedo de ingeniería	Wet Etching	6	19,25	0	18,92	6
HOLD-EQP	Paro de la secuencia del run cuando un equipo requerido inminentemente está en r	Standard Production	25	0	0	0	25
HOLDICTS	Parada de fabricación por ICTS	Standard Production	25	0	0	0	25
HOLDRESP	Parada de fabricación causada o solicitada por el responsable	Standard Production	25	0	0	0	25
ICAMPC25	I.I. DE CAMPO (CMOS-25)	Ionic Implantation	4	22,38	1,03	0	4
IF&DNC25	I.I. REGIONES N++ (CMOS-25)	Ionic Implantation	4	22,38	1,96	0	4
IF&DPC25	I.I. REGIONES P++	Ionic Implantation	4	22,38	1,29	0	4
IGATEC25	I.I. AJUSTE VT (CMOS-25)	Ionic Implantation	4	22,38	1,96	0	4
IMIMCING	Implantación en el IMC-210rd	Ionic Implantation	4	22,38	1,96	0	4
IMP-HIGH	Implantacion ionica de alta dosis	Ionic Implantation	4	22,38	2,26	0	4
IMP-LOW	Implantacion ionica de dosis baja	Ionic Implantation	4	22,38	1,96	0	4
IMP-SUP	Implantacion ionica de muy alta dosis	Ionic Implantation	4	22,38	2,87	0	4
IMPL-ING	Implantación iónica de ingeniería	Ionic Implantation	4	22,38	2,87	0	4
INICIO	PREPARAR EL INICIO DEL RUN	Standard Production	24	0,2	0	0	24
IPOUNC25	I.I. PARA POZO N (CMOS-25)	Ionic Implantation	4	22,38	2,26	0	4
IPOUPC25	I.I. PARA POZO P (CMOS-25)	Ionic Implantation	4	22,38	1,71	0	4
MARC-EAL	OBL. EPI. CMOS25	Standard Production	1	0	55,94	0	1
MARC-EAO	OBL. EPI. CMOS175	Standard Production	1	0	30,93	0	1

Tarifas de Procesos por encomienda actualizadas a Marzo 2024

Etapa	Description	Area	Wafers	Cost /run (€)	Cost /wafer (€)	Cost /batch (€)	Wafer/batch
MARC-ESP	OBLEAS ESPECIALES	Standard Production	1	0	0,04	0	1
MARC-EXT	OBLEAS EXTERIORES	Standard Production	1	0	0,04	0	1
MARC-GEN	OBLEAS VARIAS	Standard Production	1	0	0,04	0	1
MARC-NAA	OBLEAS N, 1-12 OHM.CM	Standard Production	1	0	12,54	0	1
MARC-PAA	OBLEAS P, 4-40 OHM.CM	Standard Production	1	0	10,17	0	1
MARC-PAC	OBLEAS P, 0.1-1.4 OHM.CM	Standard Production	1	0	12,04	0	1
MARC-POT	OBLEAS PROYECTOS DE POTENCIA	Standard Production	1	0	0,04	0	1
MARC-PXA	OBLEAS P,4-40OHM CM,300µ SEN..	Standard Production	1	0	21,94	0	1
MARC-PXB	OBL. P, 10-200HM.CM 500µ 2 PUL	Standard Production	1	0	15,94	0	1
MARC-SEN	OBLEAS PROYECTOS DE SENSORES	Standard Production	1	0	0,04	0	1
MARC-SOI	OBLEAS TIPO SOI	Standard Production	1	0	0,04	0	1
MARC-TEC	OBLEAS TECNOLOGIA DE SILICIO	Standard Production	1	0	0,04	0	1
MARCAR	MARCAR OBLEAS	Standard Production	1	0	0,04	0	1
MARCN150	OBLEAS N, 1-30OHM.CM 150mm 675µm	Standard Production	25	0	21,71	0	25
MARCPY05	OBLEAS PYREX 0,5 mm/con flat	Standard Production	25	0	25,93	0	25
MAU-U400	Metalización en la evaporadora Leybold-Univex 400	Metallization	1	6,18	61,6	0	1
MAU-UIING	Deposición por evaporación de capas o multicapas en las que se requiera Au.	Metallization	4	6,18	61,42	1,57	4
MEALCU	DEPOSICION DE AL/CU	Metallization	4	0	2,32	12,49	4
MEALSICU	DEPOSICION DE AL/SI/CU	Metallization	4	0	2,83	12,49	4
MES-ESP	MEDIDAS ESPECIALES	Inspection and Measur	6	0,3	0	0	6
MES-NANO	MEDIR EN EL NANOSPEC	Inspection and Measur	6	0,3	0,04	0	6
MES-PERF	Caracterización topográfica de superficies mediante un perfilómetro Tencor P7 para la deterr	Inspection and Measur	6	0,3	0,02	0	6
MES-PRO	Medida de grosor de obleas mediante el uso del equipo Proforma300	Inspection and Measur	10	0,3	0	0	10
MES4Punt	Medida de la resistividad de una muestra mediante el uso de un medidor de 4-puntas CHAN	Inspection and Measur	6	0,3	0,13	0	6
MESSTRES	Caracterización del stress mecánico residual provocado en una oblea tras un proceso median	Inspection and Measur	4	0,3	0,03	0	4
MEV-U400	Metalización en la evaporadora leybold-Univex 400	Metallization	1	6,18	1,22	0	1
MEV-UIING	Deposición por evaporación de cualquier capa o multicapa excepto de Au o de Pt.	Metallization	4	6,18	1,04	1,57	4
MEVPKING	Evaporación de Ti, Al o Cr.	Metallization	1	6,18	1,04	1,57	1
MEV-CUGR	Evaporación de Cu grueso en Univex 450	Metallization	1	6,18	0	2,89	1
MK500ING	metalización en sputtering KS500C	Metallization	1	0	2,59	12,72	1
MK800ING	Metalización en sputtering KS800H	Metallization	1	0	2,78	12,72	1
MKS800HR	Metalización en el sputtering KS800HR	Metallization	4	0	2,78	12,72	4
MPT-U400	Metalización en la evaporadora Leybold-Univex 400	Metallization	1	6,18	33,56	0	1
MPT-UIING	Deposición por evaporación de capas o multicapas en las que se requiera usar Pt.	Metallization	4	6,18	33,38	1,57	4
MRC-ING	DEPOSITO MRC-MCM POR INGENIERO	Metallization	6	11,86	0	63,65	6
MRCTNING	Deposito de Ti o Ni por ingeniero	Metallization	6	11,86	0	5,84	6
MSAULESS	Depósito selectivo de oro por método químico (Electroless)	Microsystems	1	0	61,38	0	1
MSKOHING	Micromecanizado del silicio en volumen en KOH en trozos o obleas especiales	Microsystems	6	0	0	229,69	6
MSKOHMNC	Micromecanizado del silicio en volumen mediante KOH en obleas contaminadas	Microsystems	6	0	0	229,69	6
MSKOHXXX	Micromecanizado del silicio en volumen en KOH para obleas limpias	Microsystems	6	0	0	229,69	6
MSLIFING	Estructuración de capas de metal sin grabado químico. Procesos especiales	Microsystems	4	0	0	15,2	4
MSLIFTOF	Estructuración de metal sin grabado químico	Microsystems	4	0	4,56	0	4
MSMETAL	Grabado de metales en Microsistemas	Microsystems	8	0,98	0	3,98	8
MSNILESS	Depósito selectivo de níquel por método químico (Electroless)	Microsystems	2	0	16,9	6,19	2
MSRCAMNC	Limpieza RCA en obleas de vidrio y obleas MNC	Microsystems	4	17,32	0	9,12	4
MST-ESP	Procesado no estándar de muestras en el laboratorio de microsistemas	Microsystems	4	0	17,04	0	4
MSTMHING	Micromecanizado del silicio en volumen en TMAH en trozos o obleas especiales	Microsystems	6	0	0	492,69	6
MSTMHMNC	Grabado anisótropo de silicio en TMAH para obleas contaminadas	Microsystems	6	0	0	248,69	6
MSTMHXXX	Micromecanizado del silicio en volumen mediante TMAH en obleas limpias	Microsystems	6	0	0	248,69	6
MZ550ING	Metalización de Al de ingeniería en el sputtering Leybold Z550	Metallization	4	11,86	2,32	0,64	4
NET1-SIC	Limpieza general para obleas de SiC	Wet Etching	24	20,71	0	21,16	24
NET2-SIC	Limpieza general para obleas de SiC previa a una oxidación	Wet Etching	24	24,64	0	29,87	24
NET3-SIC	Limpieza general para obleas de SiC previa a un recocido a alta temperatura	Wet Etching	24	23,98	0	29,87	24
NET4-SIC	Limpieza general para obleas de SiC al inicio de run	Wet Etching	24	20,71	0	34,67	24
NETE-SIC	LIMPIEZA ESPECIAL DE SIC Y/O GAN	Wet Etching	24	24,64	0	29,87	24
NETG-DIS	Limpieza con disolventes (Acetona / IPA)	Wet Etching	12	2,9	0	26,26	12
NETG-ESP	LIMPIEZA ESPECIAL	Wet Etching	24	19,25	0	18,66	24
NETG-GEN	Limpieza general	Wet Etching	24	20,71	0	27,37	24
NETG-HF	Limpieza general con HF	Wet Etching	24	4,36	0	18,66	24
NETG-ING	Limpieza húmeda de ingeniería	Wet Etching	6	20,71	0	27,37	6
NETG-MNC	Limpieza general en MNC	Wet Etching	24	20,71	0	23,84	24
NETG-RCA	Limpieza RCA	Wet Etching	12	19,25	0	33,81	12
NETG-SIC	LIMPIEZA GENERAL PARA OBLEAS DE SIC	Wet Etching	24	20,71	0	21,16	24
NETG-SIM	Limpieza simple	Wet Etching	24	19,25	0	18,66	24
NETGH2OC	LIMPIEZA CON AGUA OBLEAS-MET	Wet Etching	24	1,16	0	18,66	24
NETGH2OS	LIMPIEZA CON AGUA SIN METAL	Wet Etching	24	1,16	0	18,66	24
NETHFMNC	Limpieza general con HF al 5 % en MNC	Wet Etching	24	4,36	0	15,13	24
NETS-MNC	Limpieza simple en MNC	Wet Etching	24	19,25	0	15,13	24
NH2O-MNC	Limpieza con agua en MNC	Wet Etching	24	1,16	0	15,13	24
O&R-ESP	OXIDACION O RECOCIDO ESPECIAL	Thermal Process	24	11,21	0	39,28	24
O&R-ING	Proceso de oxidación o recocido de ingeniería	Thermal Process	10	11,21	0	54,78	10
OBLEAS	INCORPORAR OBLEAS DEL RESPONS.	Standard Production	1	0	0	0	1
ODPPOAAA	DOPADO POC13 DEL POLY O CMOS25	Thermal Process	24	10,2	0	11,43	24
OFLDFAAD	FLUID.OXIDO INTERNIVEL CMOS25	Thermal Process	49	10,12	0	12,49	49
OHC-0780	OXIDACION DE PUERTA DE 780A	Thermal Process	49	11,21	0	35,11	49
OHC-1000	OXID.DE 1000Å A 950°C	Thermal Process	49	11,21	0	43,31	49
OHC-1M	OXIDACION DE 1 µM A 1100°C	Thermal Process	49	11,21	0	26,6	49
OHC-1M5	OXIDACION DE 1.5 MICRAS	Thermal Process	49	11,21	0	41,24	49
OHC-4000	OXIDO HUMEDO DE 4000Å A 1100Cº	Thermal Process	49	11,21	0	16,36	49
OHC-8000	OXIDACION HUMEDA DE 8000Å	Thermal Process	49	11,21	0	22,13	49
OHC-XXX	OXIDO VARIABLE A 1100°C	Thermal Process	49	11,21	0	26,6	49
OPOC4800	DOPAJE POC13 DE 4800Å DE POLY	Thermal Process	24	10,2	0	10,78	24
OPOC6000	DOPADO POC13 DE 6000Å DE POLY	Thermal Process	24	10,2	0	11,65	24
ORCALAAA	RECOCIDO ALUMINIO CMOS25	Thermal Process	49	4,17	0	6,81	49
ORECNEUT	RECOCIDO A DIF. TEMPERATURAS	Thermal Process	49	10,12	0	15,07	49
ORECOXID	RECOCIDO A DIF. TEMPERATURAS	Thermal Process	49	10,12	0	16,26	49
OREPOAAA	RECOCIDO DE POZO CMOS25	Thermal Process	49	10,12	0	31,45	49
OSC-0300	OXID.SECA DE 300Å A 1000°C	Thermal Process	24	10,12	0	21,48	24
OSC-0500	OXID. SECA DE 500Å A 1000°C	Thermal Process	24	10,12	0	53,47	24
OX800AAA	OXID. SECA A 800°C	Thermal Process	24	10,12	0	10,21	24
OX800DLA	OXID. DILUIDA A 800°C	Thermal Process	24	10,12	0	10,64	24
OXCMAAA	OXIDACION DE CAMPO (CMOS25)	Thermal Process	24	11,21	0	53,89	24
OXINAAA	OXIDO INICIAL CMOS25	Thermal Process	24	10,12	0	21,23	24
OXNT-RIE	ATAC PER RIE DE LA PASSIVACIO	Dry Etching	0	59,28	0,59	0	0
OXPDAAA	OXIDO DE PEDESTAL CMOS25	Thermal Process	24	10,12	0	38,12	24

Tarifas de Procesos por encomienda actualizadas a Marzo 2024

Etapa	Description	Area	Wafers	Cost /run (€)	Cost /wafer (€)	Cost /batch (€)	Wafer/batch
OXPOAAA	OXIDACION DEF. POZO N (CMOS25)	Thermal Process	24	11,21	0	17,06	24
OXPTAAA	OXIDO DE PUERTA CMOS25	Thermal Process	24	10,12	0	69,35	24
OXPTAAB	OXIDACION DE PUERTA.250Å	Thermal Process	24	0	0	0	24
OXPVAAA	OXIDO SACRIFICIAL 920Å CMOS25	Thermal Process	24	10,12	0	76,95	24
P601-ESP	Grabado de diferentes materiales en el DRIE ALCATEL 601E	Dry Etching	0	37,84	19,66	0	0
P601-ING	Grabado de diferentes materiales a múltiples profundidades en Alcatel 601-E.	Dry Etching	10	37,84	19,66	0	10
P601CONT	Grabado profundo de contactos en el Alcatel 601-E	Dry Etching	1	21,04	13,87	0	1
P601DEEP	Grabado profundo de silicio en el alcatel 601-E	Dry Etching	0	25,78	19,66	0	0
P601POLI	Grabado de polisilicio en el Alcatel 601-E	Dry Etching	1	37,84	0,32	0	1
PAMI-ESP	Grabado de diferentes materiales en el AMI ETCH P-5000	Dry Etching	10	47,45	0,65	0,25	10
PAMINPAS	Grabado de nitruro de silicio de pasivación en el AMI ETCH P-5000 en obleas CMOS	Dry Etching	10	47,45	0,66	0,25	10
PAMIOPAS	Grabado de óxido de pasivación en el AMI ETCH P-5000 en obleas CMOS.	Dry Etching	10	47,45	0,65	0,25	10
PAMS-ESP	Grabado de diferentes materiales en el ALCATEL AMS-110 DE en obleas MNC	Dry Etching	0	37,84	15,49	0	0
PAMS-ING	Grabado seco de diferentes capas para obleas MNC	Dry Etching	0	37,84	15,49	0	0
PAMS-OX	Grabado de dielectricos para obleas MNC	Dry Etching	0	25,12	0,46	0	0
PAMS-POL	Grabado por RIE de capas poliméricas orgánicas	Dry Etching	1	0,09	2,2	0	1
PAMSDEEP	Grabado profundo de Silicio en obleas MNC en Alcatel AMS 110	Dry Etching	0	21,04	15,49	0	0
PGIDPC25	DECAPADO EN SECO DE POLISILICIO CARA POSTERIOR CMOS25 EN GIR 160	Dry Etching	1	25,38	0,31	0	1
PGIDPXXX	DECAPADO EN SECO DE POLISILICIO LA CARA POSTERIOR EN GIR 160	Dry Etching	1	25,38	0,31	0	1
PGINISEN	GRABADO SECO DE NITRURO DE SILICIO PARA SENSORES EN GIR 160	Dry Etching	1	34,15	0,43	0	1
PGINIXXX	GRABADO SECO DE NITRURO DE SILICIO EN GIR 160	Dry Etching	1	34,15	0,35	0	1
PGIOPC25	GRABADO EN SECO DE OXIDO DE PASIVACION EN GIR 160	Dry Etching	1	25,38	0,4	0	1
PGIOXGUI	GRABADO EN SECO DE OXIDO DE SILICIO PARA GUIAS EN GIR 160	Dry Etching	1	25,38	2,2	0	1
PGIOXXXX	GRABADO EN SECO DE OXIDO DE SILICIO EN GIR 160	Dry Etching	1	25,38	0,59	0	1
PGIPOXXX	GRABADO EN SECO DE POLISILICIO EN GIR 160	Dry Etching	1	37,84	0,28	0	1
PGISPC25	GRABADO EN SECO DE OXIDO DE SILICIO PARA "SPACER" EN GIR 160	Dry Etching	1	25,38	0,93	0	1
PGIVIC25	GRABADO SECO DE OXIDO DE SILICIO DE LAS VIAS EN GIR 160	Dry Etching	0	25,38	0,63	0	0
POXF-1AL	Grabado seco de Al entre 0,5 - 1,5 um en Oxford Plasmalab System 100	Dry Etching	0	31,33	0,48	0	0
POXF-2AL	Grabado seco de Al entre 1,5 - 3 um de Al en Oxford Plasmalab System 100	Dry Etching	0	31,33	0,87	0	0
POXF-ESP	Grabado seco no standard en Oxford Plasmalab System 100	Dry Etching	0	31,33	0,48	0	0
POXF-ING	Grabado de ingeniería de Aluminio en el Oxford Plasmalab System 100	Dry Etching	0	31,33	0,68	0	0
PQ1NIC25	GRABADO NITRURO CMOS25	Dry Etching	24	0	0	0	24
PQ2ALC25	GRABADO DE AL DEL CMOS 25	Dry Etching	24	0	0	0	24
PRE-GRAV	BARREL RES.DE MEJORA DE GRAV.	Wet Etching	25	0,16	0	0	25
PREG-MNC	Barrel de resina para mejorar el grabado en MNC	Wet Etching	0	0,16	0	0	0
PROC-URG	PROCEDIMIENTO DE URGENCIA	Standard Production	0	0	0	0	0
PROCRECU	Procedimiento de Recuperación de un run o subsanación de un defecto	Standard Production	0	0	0	0	0
PROT-BII	Net, 162cares. D.U.V+ Bake fins 180°C de resina 6512. Foto previa	Photolithography	24	0,22	0	0	24
PROT-GEN	Net,1o2cares. Depositar resina 6512 sobre cara pulida+Bake 125°C	Photolithography	1	0,22	3,2	0	1
PROT-GHU	Net, 162 cares. Només Bake 125°C Resina 6512. Foto previa	Photolithography	24	0,22	0	0	24
PROT-GS	Recocido de la resina previo a grabado seco	Dry Etching	15	0,22	0	0	15
PROT-SIC	DEPOSITO DE RESINA PARA PROTECCION EN SIC	Photolithography	1	0,22	2,11	0	1
PSECL-AL	Grabado RIE de capas de 0.5-2 µm de aluminio CMOS con química de cloro	Dry Etching	1	51,16	0,77	0	1
PSECLESP	Grabado de capas CMOS por RIE con química de cloro	Dry Etching	1	51,16	0,96	0	1
PSECLING	Grabado de ingeniería en RIE de capas CMOS con química de cloro	Dry Etching	1	51,16	1,36	0	1
PSESIING	Grabado de ingeniería en RIE de capas de silicio y carburo de silicio	Dry Etching	1	21,04	3,01	0	1
QDAL-SIC	DECAPADO DE ALUMINIO EN MUESTRAS SIC	Wet Etching	25	2,9	0	34,82	25
QDNITC25	Decapado de nitruro CMOS 25	Wet Etching	24	0,75	0	56,32	24
QDNITXXX	Decapado de nitruro	Wet Etching	24	0,75	0	56,32	24
QDOX1C25	Decapado del 1er óxido de CMOS-25	Wet Etching	24	2,9	0	22,19	24
QDOX2C25	Decapado del 2º óxido de CMOS-25	Wet Etching	24	2,9	0	22,19	24
QDOXXXX	Decapado de óxido dopado	Wet Etching	24	2,9	0	35,3	24
QDOXNC25	Decapado del oxo-nitruro	Wet Etching	24	2,9	0	22,19	24
QDOXTXXX	Decapado de óxido térmico sin Al	Wet Etching	24	2,9	0	22,19	24
QDPSGC25	DECAPADO DEL PSG DEL CMOS-25	Wet Etching	24	2,9	0	22,83	24
QDRACMNC	Decapado de resina en ácido en MNC	Wet Etching	24	35,59	0	15,13	24
QDRACXXX	Decapado de resina en ácido	Wet Etching	24	35,59	0	18,66	24
QDRDIXXX	Decapado de resina en disolvente	Wet Etching	24	16,2	0	18,66	24
QGACXXX	Grabado de Al/0.5% Cu/0.75% Si	Wet Etching	24	2,9	0	56,37	24
QGAL-SIC	GRABADO DE ALUMINIO CON MASCARA DE RESINA EN SIC	Wet Etching	15	2,9	0	34,82	15
QGALCXXX	Grabado de Al/0.5% Cu	Wet Etching	24	2,9	0	41,03	24
QGALSXXX	Grabado de Al/1% Si	Wet Etching	24	2,9	0	56,37	24
QGNITMNC	Grabado de nitruro de silicio en MNC	Wet Etching	6	0,75	0	53,41	6
QGOX-SIC	Grabado de óxido con máscara de resina sobre SIC	Wet Etching	25	2,9	0	15,98	25
QGOX-XXX	Grabado de óxido sin máscara	Wet Etching	24	2,9	0	22,19	24
QGOX0300	Grabado de óxido de 300 Å	Wet Etching	24	2,9	0	22,19	24
QGOX1C25	Grabado de óxido sacrificial	Wet Etching	24	2,9	0	22,19	24
QGOX2500	Grabado de óxido de 2500 Å	Wet Etching	24	2,9	0	22,19	24
QGOX8000	Grabado de óxido de 8.000Å	Wet Etching	24	2,9	0	25,47	24
QGOXDXXX	Grabado de óxido dopado	Wet Etching	24	2,9	0	35,3	24
QGOXNXXX	Grabado de óxido con máscara de nitruro	Wet Etching	24	2,9	0	35,3	24
QGOXRXXX	Grabado de óxido con máscara de resina	Wet Etching	24	2,9	0	22,19	24
QPRMEC25	Decapado de óxido previo a la metalización	Wet Etching	24	2,9	0	35,94	24
QREDUC25	Limpieza pre-deposición de poli	Wet Etching	24	2,9	0	53,21	24
QSC-ING	Ataque húmedo en MNC por el ingeniero	Wet Etching	4	26,3	0	12,48	4
QSCALMNC	Grabado húmedo de Al en MNC	Wet Etching	24	2,9	0	55,02	24
QSCAUMNC	Grabado húmedo de Au	Wet Etching	10	2,9	0	14,36	10
QSCDRMNC	Decapado de resina en húmedo con MNC	Wet Etching	24	2,9	0	70,98	24
QSCNGMNC	LIMPIEZA CON AGUA CON M.N.C.	Wet Etching	24	1,16	0	12,23	24
QSCNIMNC	Grabado húmedo de Ni en MNC	Wet Etching	10	1,16	0	18,16	10
QSCOXMNC	Grabado de óxido en MNC	Wet Etching	24	26,3	0	12,48	24
QSCPMNC	Paso previo a la metalización MNC	Wet Etching	24	2,9	0	29,5	24
QSCCTMNC	Grabado tricapa Ti/Ni/AU MCM	Wet Etching	10	2,9	0	39,02	10
QSCITMNC	Grabado húmedo de Ti con MNC	Wet Etching	10	2,9	0	23,13	10
REC-ALU	RECOCIDO ALUMINIO A 450°C	Thermal Process	24	4,13	0	3,21	24
RTPA-ING	Recuit/oxidació a l'equip AS-ONE-200	Standard Production	1	9,52	0	3,25	1
RTPD-ING	Proces de recuita rapida o RTCVD a l'equip AS-Master 2000	Thermal Process	1	9,52	0	3,25	1